

InGaAs фотодиод 1654 нм, 1000 мкм, ТО-корпус с линзой — техническое описание

P/N : WIT3-1000BA

ОСОБЕННОСТИ

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

Детектирование в ближнем ИК-диапазоне

Мониторинг

Измерительные приборы

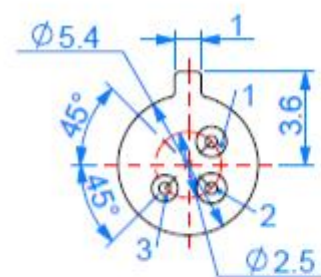
Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Чувствительность	R	@1550nm	-	1.0	-	А/Вт
		@1650nm	-	1.0	-	А/Вт
Темновой ток	Id	VR=-5V	-	0.5	2.5	нА
Рабочий диапазон длин волн	λ	-	900	1650	1740	нм
Активная область	φ	-	1000			мкм
Емкость	C	VR=-5V,1MHz	-	55	65	пФ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	Top	-40	25	85	°C
Температура хранения	Tstg	-40	-	120	°C
Напряжение обратного смещения	Vbr	20	38	60	В
Линейная мощность насыщения	VR=0V	-	4	-	мВт
Температура пайки	Tsold	-	-	260/10	°C/s

Назначение выводов и габаритный чертёж



PD 引脚定义

